

Title (en)
CRYSTALLISATION PROCESS.

Title (de)
KRISTALLISATIONSVERFAHREN.

Title (fr)
PROCEDE DE CRISTALLISATION.

Publication
EP 0489900 A1 19920617 (EN)

Application
EP 91912797 A 19910703

Priority
GB 9014723 A 19900703

Abstract (en)
[origin: WO9201089A1] In a process for the crystallisation of amorphous silicon, gold is disposed in intimate contact with the amorphous silicon, and the silicon and the gold are annealed at a temperature of at least 400 C. The amorphous silicon is preferably deposited on a substrate, with the gold disposed over the silicon or between the silicon and the substrate. The gold may be deposited as a matrix of dots.

Abstract (fr)
Dans un procédé de cristallisation de silicium amorphe, de l'or est placé en contact intime avec le silicium amorphe, et le silicium et l'or sont recuits à une température d'au moins 400 °C. Le silicium amorphe est de préférence déposé sur un substrat, l'or étant placé sur le silicium ou entre le silicium et le substrat. L'or peut être déposé sous forme d'une matrice de points.

IPC 1-7
C30B 1/02; **C30B 29/06**; **H01L 21/20**

IPC 8 full level
C30B 1/02 (2006.01); **C30B 29/06** (2006.01); **H01L 21/20** (2006.01); **H01L 21/324** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C30B 1/023 (2013.01 - EP); **C30B 29/06** (2013.01 - EP); **H01L 21/02381** (2013.01 - EP); **H01L 21/02532** (2013.01 - EP); **H01L 21/02595** (2013.01 - EP); **H01L 21/02672** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
See references of WO 9201089A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GR NL

DOCDB simple family (publication)
WO 9201089 A1 19920123; EP 0489900 A1 19920617; GB 2245552 A 19920108; GB 9014723 D0 19900822; GB 9114398 D0 19910821; JP H05501701 A 19930402

DOCDB simple family (application)
GB 9101086 W 19910703; EP 91912797 A 19910703; GB 9014723 A 19900703; GB 9114398 A 19910703; JP 51201691 A 19910703